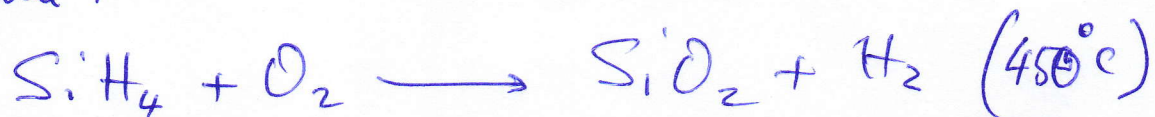
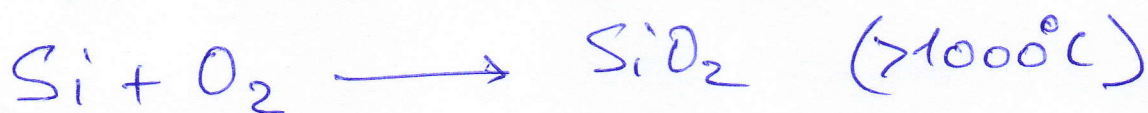


Les caractéristiques importantes sont la constante de diffusion ² et la profondeur de la puctum x_j .

d) Il existe deux types d'oxydation du silicium le dépôt pyrolytique, se faisant à relativement basse température.



~~Le dépôt~~ l'oxydation thermique du silicium



e) Parmi les techniques de croissance cristalline du Si

→ la technique de CZOCHRALSKI CZ

à creuset fixe et tirage à partir de la silicium fondu. (peut être caractérisée par une concentration élevée de O_2 due aux parois du Quartz), faible concentration de dislocations.

→ La technique de la Zone Fondue FZ.

caractérisée par une zone fondue mobile qui permet d'obtenir un cristal très pur, mais sujette à une forte concentration de dislocations.

f) on mesure expérimentalement la résistivité d'une couche diffusée par la technique des 04 points, ou on injecte un courant sur un échantillon et on mesure la tension aux 4 points (courant et tension sur les 4 points).